

Содержание

- *Международная конференция Физика.СПб, 21–25 октября 2024 г., Санкт-Петербург*

Денисюк С.В., Куданович О.Н., Мухуров Н.И., Ходин А.А., Уткина Е.А., Меледина М.В., Таболич А.А.
Сравнительная морфология и фотолюминесценция пленок ZnO, полученных методами SILAR и вакуумного напыления 587

Гагарина А.Ю., Безверхний В.П., Муратова Е.Н., Мошников В.А., Врублевский И.А., Тучковский А.К., Лушпа Н.В.
Получение и свойства наноразмерной пленки диоксида титана для транспортного слоя *n*-типа фотовольтаической ячейки 591

- *XVI Российская конференция по физике полупроводников. 7–11 октября 2024 г., Санкт-Петербург*

Иванов А.А., Чалдышев В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Лундин В.В., Цацульников А.Ф.
Влияние беспорядка на оптические свойства резонансных брэгговских структур на основе III-N 594

Залялов Т.М., Воронковский В.А., Герасимова А.К., Исламов Д.Р.
Оптимизация переключения мемристорных структур на основе HfO₂ с использованием электронно-лучевого воздействия 601

Пономарев С.А., Рогило Д.И., Голяшов В.А., Насимов Д.А., Кох К.А., Щеглов Д.В., Латышев А.В.
Взаимодействие атомов In с поверхностью Bi₂Se₃(0001) в процессе низкотемпературной адсорбции 606

Манцурова С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л.
Влияние свойств структурированной поверхности подложки на морфологию планарных нанопроволок GaAs (моделирование Монте-Карло) 612

- *Электронные свойства полупроводников*

Афанасьев А.Н., Грешнов А.А., Зегря Г.Г.
Конкуренция между изотропным и сильно анизотропным вкладами в темп ударной ионизации в прямозонных полупроводниках 620

- *Поверхность, границы раздела, тонкие пленки*

Дунаевский М.С., Алексеев П.А., Смирнов А.Н., Гостищев П.А., Грень Д.О., Фурасова А.Д., Саранин Д.С., Теруков Е.И.
Дендритные структурные неоднородности в тонких слоях Cs_{0.2}FA_{0.8}PbI_{2.93}Cl_{0.07} для перовскитных солнечных элементов 629

- *Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники*

Лебедев М.В., Львова Т.В., Дементьев П.А., Седова И.В., Королева А.В., Жижин Е.В., Лебедев С.В.
Эволюция состава естественного окисла на поверхности Al_{0.3}Ga_{0.7}As(100) при взаимодействии с водным раствором сульфида натрия 636

- *Физика полупроводниковых приборов*

Сидоров В.В., Петров П.В.
Исследование влияния ловушек носителей заряда на линейность ПЗС-фотоприемника 644